

第十五届全国MOCVD学术会议日程表

| 8月21日，星期二 | | 8月22日，星期三 | | 8月23日，星期四 | | 8月24日，星期五 | | | |
|-----------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| | | 8:30 | 开幕式 | 8:00 | 分会ABCD | 参观考察 8:30-15:30 | | | |
| | | | | | 邀请报告 | | | | |
| | | 9:00 | 大会报告 | | 口头报告 | | | | |
| | | 10:30 | 茶歇 | 9:55 | 茶歇 | | | | |
| | | 10:45 | 大会报告 | 10:15 | 邀请报告 | | | | |
| | | | | | 口头报告 | | | | |
| 12:15 | 午餐 | 12:00 | 午餐 | | | | | | |
| 13:30 | 注册 | 13:30 | 分会 ABCD | | 大会报告 | | | | |
| | | | | 13:30 | 邀请报告 | | | | |
| | | | | 15:00 | 茶歇 | | | | |
| | | 15:25 | 茶歇 | 15:15 | 大会报告 | | | | |
| | | 15:40 | 邀请报告 | | | | | | |
| | | | 口头报告 | 16:15 | 闭幕式 | | | | |
| 18:00 | 晚餐 18:00 - 19:30 | 17:35 | 海报张贴 | 18:00 | 晚宴 18:00- 20:00 | 返程 | | | |
| | | 18:00 | 晚餐 | | | | | | |
| | | 19:00 | 海报展示 19:00-21:00 | | | | | | |
| 展 台 | | 8月21日13:30--23日18:00 | | | | | | | |

大会报告 (30min: 25分钟报告, 5分钟问答)
 邀请报告 (25min: 20分钟报告, 5分钟问答)
 口头报告 (13min: 10分钟报告, 3分钟问答)

第十五届全国MOCVD学术会议会场分布

| | | | | |
|------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 8月22日上午 | 开幕式、大会邀请报告（二楼·衡山厅） | | | |
| | 分会场A （一楼井冈厅） | 分会场B （一楼黄山厅） | 分会场C （一楼泰山厅） | 分会场D （二楼五指峰厅） |
| 8月22日13:30 | 激光器材料与器件 （一） | LED及探测器材料与 器件（一） | 电力电子器件 （一） | 其他器件及应用 （一） |
| 8月22日15:40 | 激光器材料与器件 （二） | LED及探测器材料与 器件（二） | 电力电子器件 （二） | 其他器件及应用 （二） |
| 8月22日19:00 | 海报展示（一楼·井冈厅） | | | |
| 8月23日 8:00 | 激光器材料与器件 （三） | LED及探测器材料与 器件（三） | 电力电子器件 （三） | 其他器件及应用 （三） |
| 8月23日10:15 | 激光器材料与器件 （四） | LED及探测器材料与 器件（四） | 电力电子器件 （四） | 其他器件及应用 （四） |
| 8月23日下午 | 大会邀请报告、闭幕式（二楼·衡山厅） | | | |

第十五届全国MOCVD学术会议日程

| 8月22日（星期三） | |
|-------------|--|
| 8:30-9:00 | <p style="text-align: center;">开幕式 主持人：江风益</p> |
| | 大会报告 |
| 主持人 | 张荣 |
| 9:00-9:30 | <p>F1: 氮化物和超宽禁带半导体电子器件研究进展 郝跃 西安电子科技大学微电子学院, 西安, 710071</p> |
| 9:30-10:00 | <p>F2: Illuminating the World: Metalorganic Chemical Vapor Deposition of III-V Compound Semiconductor Devices Prof. Russell D. Dupuis, Steve W. Chaddick Chair in Electro-Optics Georgia Institute of Technology School of Electrical and Computer Engineering Center for Compound Semiconductors 777 Atlantic Drive NW Atlanta GA 30332-0250</p> |
| 10:00-10:30 | <p>F3: 超宽禁带氧化镓半导体器件 刘明 中国科学院微电子器件与集成技术重点实验室</p> |
| 10:30-10:45 | 茶歇 |
| 主持人 | 杨辉 |
| 10:45-11:15 | <p>F4: 王立军</p> |
| 11:15-11:45 | <p>F5: III族氮化物半导体的制备与纳米结构发光器件研究 张荣 厦门大学, 厦门 361005; 南京大学电子学院, 南京210093</p> |
| 11:45-12:15 | <p>F6: 紫外LED的产业机遇与技术挑战 李晋闽 中国科学院半导体研究所, 半导体照明联合创新国家重点实验室, 北京 100083</p> |

| 12:15-13:30 | 午餐 | | | |
|-------------|---|---|---|---|
| 分会报告 | 激光器材料与器件 (一) | LED及探测器材料与器件 (一) | 电力电子器件 (一) | 其他器件及应用 (一) |
| 主持人 | 杨学林 | 王军喜 | 杨树 | 王成新 |
| 13:30-13:55 | <p>IA1(邀请报告): 硅基GaN光电子器件的异质外延生长研究进展 孙钱*, 杨辉 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 苏州 215123 中国科学院苏州纳米器件及应用重点实验室, 苏州 215123</p> | <p>IB1(邀请报告): 宽禁带半导体紫外光电探测器 陆海 南京大学电子科学与工程学院</p> | <p>IC1(邀请报告): Modeling for MOCVD process and device optimization Roman Talalaev STR Group, St.Petersburg, Russia</p> | <p>ID1(邀请报告): 基于多色荧光粉转换的全光谱、健康照明LED光源 刘国旭 南昌易美光电科技有限公司</p> |
| 13:55-14:20 | <p>IA2(邀请报告): 硅基GaAs和InP材料的生长研究 潘教青 周旭亮 李士颜 李稚博 王梦琦 于红艳 王圩 中国科学院半导体研究所 中国科学院大学</p> | <p>IB2(邀请报告): Research of emerging ultrawide bandgap semiconductor materials and devices Xiaohang Li Advanced Semiconductor Laboratory Electrical Engineering King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)</p> | <p>IC2(邀请报告): 高性能GaN基电力电子器件研究 张进成 郝跃 西安电子科技大学, 宽禁带半导体技术国家级重点实验室</p> | <p>ID2(邀请报告): The implementation of Gbps real time visible light communication system. 迟楠, 缪小龙 南京智雅信息科技有限公司</p> |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| <p>14:20-14:33</p> | <p>OA1 (口头报告): Pit 缺陷对 GaN 中载流子行为的影响 开翠红1,2, 孙晓娟1, 贾玉萍1, 石芝铭1, 蒋科1,2, 贲建伟1,2, 吴忧1,2, 王勇1,2, 刘贺男1, 黎大兵1* 1长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130013 2中国科学院大学, 北京 100039</p> | <p>OB1 (口头报告): 深紫外非极性、半极性 AlGaIn 基多量子阱的 MOCVD 生长 赵见国, 张雄*, 何佳琦, 范艾杰, 吴自力, 陈帅, 崔一平 东南大学, 电子科学与工程学院先进光子学中心, 南京 210096</p> | <p>OC1 (口头报告): 利用低温 AlN 缓冲层 HVPE 技术生长 GaN 衬底研究 刘南柳*, 王琦, Yilmaz Dikme, 郑小平, 张国义 北京大学东莞光电研究院, 东莞 523808</p> | <p>OD1 (口头报告): 蓝宝石衬底可重复 AlGaIn/GaN 共振隧穿二极管研究 王丁1,2,3*, 陈兆营2, 王涛2, 杨流云2, 苏娟3, 谭为3, 郭世平4, 张健3, 王新强2 1清华大学工程物理系, 北京 100084 2北京大学物理学院, 宽禁带半导体研究中心, 北京 100871 3中国工程物理研究院微系统与太赫兹研究中心, 四川成都 610299 4中微半导体设备有限公司, 上海 201201</p> |
| <p>14:33-14:46</p> | <p>OA2 (口头报告): 垂直结构紫外 LED 在 β-Ga₂O₃ 衬底上的 MOCVD 生长 李丁 中国科学院北京纳米能源与系统研究所, 中科院纳米科学卓越创新中心, 微纳能源与传感北京市重点实验室, 北京 100083 中国科学院大学, 纳米科学与技术学院, 北京 1000049</p> | <p>OB2 (口头报告): 研究 NH₃ 在 InGaIn 生长过程中的腐蚀作用 杨静, 赵德刚, 江德生 中国科学院半导体研究所, 集成光电子学国家重点实验室, 北京 100083</p> | <p>OC2 (口头报告): 选区外延发射结的 AlGaIn/GaN 异质结双极晶体管 张韵1*, 张连1, 曾建平2, 程哲1, 路红喜1, 吕宏瑞1, 艾玉杰1, 贾利芳1 1中国科学院半导体研究所, 北京 100083 2中国工程物理研究院微系统与太赫兹中心, 成都 610299</p> | <p>OD2 (口头报告): InN 本征超导性质的低温磁输运测量 宋志勇1,2, 康亭亭2* 1. 华东师范大学, 极化材料与器件教育部重点实验室, 上海 200062 2. 中国科学院上海技术物理研究所, 红外物理国家重点实验室, 上海 200083</p> |
| <p>14:46-14:59</p> | <p>OA3 (口头报告): 室温电注入激射的硅衬底 III 族氮化物微盘激光器 冯美鑫, 王瑾, 周瑞, 孙钱*, 刘建勋, 高宏伟, 周宇, 黄应南, 杨辉 中国科学院纳米器件与应用重点实验室, 苏州, 215123 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 苏州, 215123</p> | <p>OB3 (口头报告): 一种基于阱点耦合隧穿结构的 526nm 绿光超辐射发光二极管 王磊, 汪莱*, 郝智彪, 罗毅, 孙长征, 韩彦军, 熊兵, 王健, 李洪涛 清华大学, 电子工程系, 北京信息科学与技术国家研究中心集成光电子学重点实验室, 北京 100084</p> | <p>OC3 (口头报告): 微波合成法制备的碳纳米点在白光 LED 器件中应用的研究 张盛楠, 云峰*, 李虞锋 西安交通大学, 电子物理与器件教育部重点实验室, 固态照明工程研究中心, 西安 710049</p> | <p>OD3 (口头报告): 具有高生长速率的高质量 AlN 模板制备 吴华龙, 赵维, 何晨光, 张康, 贺龙飞, 刘小平, 廖乾光, 刘云洲, 刘宁扬, 陈志涛* 广东省半导体产业技术研究院, 广东省科学院, 广州 510651</p> |

| | | | | |
|-------------|--|--|---|---|
| 14:59-15:12 | <p>OA4 (口头报告): 2英寸双面抛光AlN模板制备 陈一仁, 张志伟, 蒋红, 缪国庆, 李志明, 宋航* 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130033</p> | <p>OB4 (口头报告): 具电子减速层之深紫外发光二极管 卓昌正*, 陈圣昌, 邓和清, 臧雅姝, 徐宸科 三安光电股份有限公司, 厦门 361009</p> | <p>OC4 (口头报告): p-GaN 栅帽层增强型 HEMT器件中SiO2/SiNx钝化层影响研究 张东, 徐尉宗*, 曾昶琨, 周东, 任芳芳, 张荣, 郑有焯, 陆海* 南京大学电子科学与工程学院, 南京210023</p> | <p>OD4 (口头报告): 全自动采集并分析基于GaN的异质外延薄膜X射线倒易空间数据 鲍朝辉*, J.F. Voitok, L. Grieger, G. Tye (荷兰帕纳科) PANalytical B.V., Lelyweg 1, 7602EA Almelo, The Netherlands</p> |
| 15:12-15:25 | <p>OA5 (口头报告): 绿光激光器InGaN量子阱有源区界面trench缺陷研究 田爱琴, 刘建平*, 张立群, 黄思溢, 周伟, 池田昌夫, 张书明, 李德尧, 张峰, 温鹏雁, 杨辉 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 纳米器件与应用重点实验室, 苏州 215123</p> | <p>OB5 (口头报告): 利用3D-2D生长法与侧向外延技术外延非极性GaN 严珅 迭俊琇 王彩玮 胡小涛 胡巍 江洋* 陈弘 北京凝聚态物理国家实验室, 中国科学院物理研究所 北京新能源材料与器件重点实验室 100190</p> | <p>OC5 (口头报告): 超薄AlN插入层对高Al组分AlGaIn量子阱特性的影响 骆宗艳, 卢诗强, 王传家, 李金钗*, 陈航洋, 刘达艺, 杨旭, 康俊勇 厦门大学物理系, 福建省半导体材料及应用重点实验室, 半导体光电材料及其高效转换器件协同创新中心, 厦门 361005</p> | <p>OD5 (口头报告): 溅射AlN/蓝宝石衬底上高质量AlN的MOCVD外延生长研究 谭波, 张毅, 龙瀚凌, 张骏, 陈长清, 戴江南* 华中科技大学, 武汉光电国家研究中心, 武汉 430074</p> |
| 15:25-15:40 | 茶歇 | | | |
| 分会报告 | 激光器材料与器件 (二) | LED及探测器材料与器件 (二) | 电力电子器件 (二) | 其他器件及应用 (二) |
| 主持人 | 孙钱 | 陆海 | 张进成 | 刘国旭 |
| 15:40-16:05 | <p>IA3 (邀请报告): 深紫外LED外延生长及器件封装最新研究进展1 陈长清*, 戴江南* 华中科技大学, 武汉光电国家研究中心, 武汉 430074</p> | <p>IB3 (邀请报告): AlGaIn基紫外发光二极管光提取研究 郭亚楠 闫建昌 张韵 王军喜* 中国科学院半导体研究所, 半导体照明研发中心, 北京 100083</p> | <p>IC3 (邀请报告): Dynamic/Switching Performance of Vertical GaIn-on-GaN Power Devices Shu Yang*, Shaowen Han, and Kuang Sheng College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, 310027 China</p> | <p>ID3 (邀请报告): 红光LED技术上的一些进展 王成新、张新、闫宝华、汤福国、吴向龙、彭璐、于军、徐现刚 山东浪潮华光光电子股份有限公司, 潍坊, 260101</p> |

| | | | | |
|-------------|---|---|--|--|
| 16:05-16:30 | <p>IA4(邀请报告):Si衬底上GaN连续厚膜的外延生长及C杂质研究 杨学林1,*，张洁1，吴珊1，石林2，葛惟昆2，王新强1，徐科2，沈波1,* 北京大学物理学院，北京 100871</p> | <p>IB4(邀请报告):Recent progress on the increase of the internal quantum efficiency for III-nitride based light-emitting diodes: principles and device physics 张紫辉1, 2, *, 田康凯1, 2, 楚春双1, 2, 张勇辉1, 2, 毕文刚1, 2, 1 天津市北辰区西平路5340号河北工业大学电子与信息工程学院微纳米光电子与电磁技术创新研究所, 300401, 中国 2 天津市电子材料与器件重点实验室, 天津市北辰区西平路5340号, 300401, 中国</p> | <p>IC4(邀请报告): Power the Future with Wide Bandgap Semiconductors Ziwen Fang AIXTRON China Limited</p> | <p>ID4(邀请报告):NAURA PVD AlN在半导体领域的应用 郭冰亮, 董博宇*, 丁培军 北京北方华创微电子装备有限公司(简称NAURA), 北京 102600</p> |
| 16:30-16:43 | <p>OA6(口头报告):基于单区量子点锁模激光器的可调谐THz拍频信号产生 丁芸芸, 高凤, 袁慧宏, 吕尊仁, 杨涛* 中国科学院半导体所, 材料科学重点实验室, 北京 100083; 中国科学院大学, 材料科学与光电技术学院, 北京 100049</p> | <p>OB6(口头报告):In组分对硅衬底GaN基InxGaN外延中V形坑形成的影响 高江东, 刘军林*, 莫春兰, 张建立, 潘拴, 江风益 南昌大学 国家硅基LED工程技术研究中心, 江西 南昌 330096</p> | <p>OC6(口头报告):硅基Al(In)GaN/GaN HEMT射频器件的外延生长研究 周宇1, 戴淑君1, 高宏伟1, 张凯2, 孙钱* 1, 陈堂胜2, 杨辉1 1. 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 苏州 215123 中国科学院苏州纳米器件和应用重点实验室, 苏州 215123 2. 中国电子科技集团第55研究所, 南京, 210016</p> | <p>OD6(口头报告):等离激元增强InGaN/GaN纳米光电化学电池的研究 桑艺萌, 刘斌*, 陶涛, 智婷, 蒋迪, 张荣 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京大学电子科学与工程学院, 南京210093</p> |
| 16:43-16:56 | <p>OA7(口头报告):高亮度半导体激光器及离轴外腔光谱合束 佟存柱1,*、孙方圆1, 2、赵宇飞1, 2、舒世立1、王立军1 1. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林长春130033 2. 中国科学院大学, 北京100049</p> | <p>OB7(口头报告):GaN基共振腔结构LED的制备研究 余焯, 张源涛*, 李鹏翀, 邓高强, 王阳, 张宝林, 杜国同 集成光电子学国家重点实验室, 吉林大学电子科学与工程学院, 长春 130012</p> | <p>OC7(口头报告):MOCVD生长AlN的表面反应模拟研究 张周, 左然* 江苏大学能源与动力工程学院, 镇江 212013</p> | <p>OD7(口头报告):InAsSb量子点的MOCVD生长及发光光谱调控 王东博, 卓宁*, 张锦川, 刘峰奇, 王占国 中国科学院半导体研究所, 半导体材料科学重点实验室, 北京 100083</p> |

| | | | | |
|--------------|--|--|---|---|
| 16:56-17:09 | <p>OA8 (口头报告): Room Temperature Polariton Lasing in GaN Microrods with Large Rabi Splitting 李俊超, 于果, 宗华, 胡晓东* 北京大学, 物理学院, 人工微结构与介观物理国家重点实验室, 北京 100871</p> | <p>OB8 (口头报告): 空腔型倾斜侧壁深紫外LED的光提取理论分析研究 张勇辉*, 楚春双, 方梦倩, 张紫辉, 毕文刚 河北工业大学, 天津300401</p> | <p>OC8 (口头报告): 基于传输线模型的2DEG输运特性无损测量 林威a, 文正b, 郝一龙b, 沈波a, 王茂俊b* a北京大学, 物理学院, 北京 100871 a北京大学, 微电子学研究院, 北京 100871</p> | <p>OD8 (口头报告): 车轮状微腔LED光电通信特性研究 朱刚毅*, 李佳平, 何丝情, 王永进 南京邮电大学, 南京 210003 *通讯作者: 朱刚毅 电话/传真: 13951773989 邮箱: zhugangyi@njupt.edu.cn</p> |
| 17:09-17:22 | <p>OA9 (口头报告): GaN表面高质量单层WS₂生长研究 曾昊, 吴志明*, 吴雅萍*, 康俊勇 福建省半导体材料及应用重点实验室, 厦门大学 物理科学与技术学院, 厦门 361005</p> | <p>OB9 (口头报告): GaN/β-Ga₂O₃核/壳纳米线的合成与表征 王爽, 修向前*, 华雪梅, 谢自力, 陈鹏, 刘斌, 张荣, 郑有焘 南京大学 电子科学与工程学院, 光电信息功能材料重点实验室, 南京210023</p> | <p>OC9 (口头报告): 采用多级变速法生长AlGaAs电流扩展层的850nm红外发光二极管 陈凯轩* 厦门乾照光电股份有限公司, 厦门 361101</p> | <p>OD9 (口头报告): i-GaN中位错密度和C杂质浓度对肖特基紫外探测器性能的影响 齐浩然, 周梅*, 易淋凯 中国农业大学, 理学院应用物理系, 北京 100094</p> |
| 17:22-17:35 | <p>OA10 (口头报告): Liquid sensor using high Q-InGaN quantum-well based microdisk Peng Hu, Yufeng Li, Mengqi Du, Sheng nan Zhang, and Feng Yun* Key Laboratory for Physical Electronics and Devices of the Ministry of Education and Shaanxi Provincial Key Laboratory of Photonics & Information Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710049, China Solid-State Lighting Engineering Research Center, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710049, China</p> | <p>OB10 (口头报告): 等离子体调控对GaN低温外延的作用机理研究 张子轩, 罗毅*, 于汪洋, 余佳东, 路博洋, 汪莱, 王健, 郝智彪, 孙长征, 韩彦军, 熊兵, 李洪涛 清华大学, 北京信息科学与技术国家研究中心, 集成光电子学重点实验室, 北京 100084</p> | <p>OC10 (口头报告): 电子注入对Si上GaN垂直漏电和缺陷态俘获效应的影响 宋春燕1, 杨学林1*, 纪攀峰1, 唐军2, 林威1, 葛惟昆1, 沈波1 1北京大学, 物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室, 北京 100871 2合肥彩虹蓝光科学技术公司, 合肥 230000</p> | <p>OD10 (口头报告): 基于宽禁带AlN半导体材料的紫外超透镜 汪炼成1*, 郭林浩1, 刘志强2, 伊晓燕2, 闫建昌2, 王军喜2, 李晋闽2 1. 中南大学, 高性能复杂制造国家重点实验室, 长沙 410083 2. 中国科学院半导体研究所, 半导体照明研发中心, 北京100083</p> |
| 17: 35-18:00 | 海报张贴 | | | |

| | |
|---|-----------|
| 18:00-19:00 | 晚餐 |
| 海报展示 (19:00-21:00) | |
| <p>P-1: 265nm深紫外激光器波导层结构优化设计 陈雪*, 臧俊微, Mussaab I. Niass, 王芳**, 刘玉怀*** 郑州大学, 郑州大学电子材料与系统实验室, 郑州 450000</p> | |
| <p>P-2: Be、S共掺杂AlN纳米片的第一性原理研究 屈艺谱, 臧俊微, 鲁正乾, 杜仲秋, 王芳*, 刘玉怀** 郑州大学, 电子材料与系统国家国际联合研究中心, 河南省电子材料与系统国际联合实验室, 信息工程学院电子与信息工程系</p> | |
| <p>P-3: 采用Mg-delta掺杂技术制备的具有高空穴浓度的非极性a面p型AlGaIn外延薄膜 吴自力, 张雄*, 范艾杰, 赵见国, 陈帅, 陈虎, 崔一平 东南大学, 电子科学与工程学院, 先进光子学中心, 南京 210096</p> | |
| <p>P-4: HT-AlN层结构对半极性(11-22)面AlGaIn外延层中背景载流子浓度的影响 杨刚, 张雄*, 庄喆, 姜海涛, 赵见国, 范艾杰, 吴自力, 陈帅, 崔一平 东南大学, 电子科学与工程学院先进光子学中心, 南京 210096</p> | |
| <p>P-5: 利用In作为表面活性剂外延生长的具有高空穴浓度的非极性a面p型GaIn/AlGaIn超晶格薄膜 范艾杰, 张雄*, 庄喆, 陈虎, 陈帅, 吴自力, 赵见国, 崔一平 东南大学, 电子科学与工程学院, 先进光子学中心, 南京 210096</p> | |
| <p>P-6: 碳杂质对p-GaN欧姆接触的影响机制 梁锋, 赵德刚* 中国科学院半导体研究所, 北京 100083</p> | |
| <p>P-7: 量子垒生长前的升温时间对InGaIn/GaN量子阱光学性质的影响 邢瑶, 赵德刚*, 江德生 中国科学院半导体研究所, 北京 100083</p> | |
| <p>P-8: MgN作插入层的半极性m面AlGaIn薄膜的生长 姜海涛, 庄喆*, 张雄, 杨刚, 赵见国, 范艾杰, 吴自力, 陈帅, 崔一平 东南大学, 电子科学与工程学院先进光子学中心, 南京 210096</p> | |
| <p>P-9: 基于非辐射共振能量转移机制的混合白光LED器件性质研究 庄喆*, 张雄, 崔一平 东南大学, 先进光子学中心, 南京 210000</p> | |
| <p>P-10: 高质量AlN模板在不同图形蓝宝石衬底上的外延 吴卓辉1,2, 闫建昌1,*, 郭亚楠1, 李晋闽1, 王军喜1,* 1. 中国科学院半导体研究所, 半导体照明研发中心, 北京 100083 2. 中国科学院大学, 北京 100083</p> | |

| |
|--|
| <p>P-11: 基于纳米多孔模板的深紫外发光二极管 张亮1,2, 闫建昌1,* , 吴清清1,2, 郭亚楠1, 李晋闽1, 王军喜1,* 1. 中国科学院半导体研究所, 半导体照明研发中心, 北京 100083 2. 中国科学院大学, 北京 100083</p> |
| <p>P-12: 基于溅射AlN厚膜的高性能深紫外LED 张韵1*, 倪茹雪1, 卓昌正2, 杨昆3, 艾玉杰1, 赵璐1, 张连1, 程哲1, 刘喆1, 贾利芳1 1中国科学院半导体研究所, 北京 100083 2三安光电股份有限公司, 厦门 361009 3河北同光晶体有限公司, 保定 071000</p> |
| <p>P-13: 基于高声速AlN材料的声表面波滤波器 张韵*, 杨帅, 艾玉杰, 吕宏瑞, 程哲, 张连, 贾利芳, 王军喜 中国科学院半导体研究所, 北京, 100083</p> |
| <p>P-14: MOCVD用高纯β-二酮稀土螯合物制备 焦鹏冲, 居住, 蔡华强*, 向恒, 张衍 中物院化工材料研究所, 四川省新材料研究中心, 成都 610200</p> |
| <p>P-15: 基于β-Ga2O3衬底的垂直LED器件研究 张翔, 魏同波*, 王军喜*, 李晋闽 中科院半导体研究所, 北京市海淀区清华东路甲35号, 北京100083</p> |
| <p>P-16: 基于石墨烯缓冲层的AlGaIn/GaN纳米柱的生长研究 任芳, 王蕴玉, 梁萌, 刘志强*, 伊晓燕, 袁国栋, 李晋闽 中国科学院半导体研究所, 北京市海淀区清华东路甲35号, 100083</p> |
| <p>P-17: 高纯二茂铁的制备 徐耀中 万欣 董礼 刘子伟 刘宇 常华 江苏南大光电材料股份有限公司 江苏苏州 215021</p> |
| <p>P-18: Monolithic semipolar InGaIn/GaN white light-emitting diodes on micro-stripped Si(100) substrate Qi Wang^{a,b}, Guodong Yu^{a,*}, Lu Zhang^{a,b}, Junxi Wang^{a,b}, Jinmin Lia^{a,b} ^a R&D Center for Semiconductor Lighting, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of Solid State Lighting, Beijing Engineering Research Center for the 3rd Generation Semiconductor Materials and Application, Beijing 100083, PR China ^b College of Materials Science and Opto-Electronic Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, PR China</p> |
| <p>P-19: 基于二硫化钨缓冲层的AlN薄膜MOCVD外延 尹越, 王蕴玉, 梁萌, 刘志强, 伊晓燕, 闫建昌, 李晋闽* 中国科学院半导体研究所, 北京市海淀区清华东路甲35号, 100083</p> |
| <p>P-20: 纳米图形化氮化铝模版上高质量氮化铝的外延生长 解楠, 许福军*, 王明星, 孙元浩, 刘百银, 沈波* 北京大学, 宽禁带半导体中心, 北京 100871</p> |
| <p>P-21: 蓝宝石不同表面预处理对高温退火AlN晶体质量影响的研究 王明星, 许福军*, 解楠, 孙元浩, 刘白银, 秦志新, 沈波* 北京大学, 宽禁带半导体研究中心, 北京 100871</p> |

| |
|---|
| P-22: 常关型Al ₂ O ₃ /GaN MOSFET边界陷阱态与界面性质联系 尹瑞苑, 李玥, 孙雨, Cheng P. Wen, 郝一龙, 王茂俊* 北京大学, 微电子研究院, 北京 100871 |
| P-23: C掺杂GaN中替代式C杂质的实验研究 徐越 ¹ , 杨学林 ^{1*} , 张鹏 ² , 曹兴忠 ² , 吴珊 ¹ , 张洁 ¹ , 葛惟昆 ¹ , 沈波 ^{1*} 人工微结构和介观物理国家重点实验室, 北京大学物理学院, 北京 100871 中国科学院高能物理研究所, 北京 100049 |
| P-24: Growth of continuous 7.3 μm-thick GaN layers on Si substrates: Towards low cost vertical GaN devices Jie Zhang ¹ , Xuelin Yang ^{1,*} , Yuxia Feng ¹ , Jianfei Shen ¹ , Bo Shen ^{1,*} ¹ State Key Laboratory of Artificial Microstructure and Mesoscopic Physics, School of Physics, Peking University |
| P-25: 利用PVD AlN缓冲层在Si(111)衬底上生长单晶GaN薄膜的研究 冯玉霞, 杨学林*, 张洁, 纪攀峰, 沈波 北京大学物理学院, 北京 100871 |
| P-26: 利用纳米压印技术在纳米图形Si衬底上生长高质量AlN的研究 沈剑飞 ¹ , 杨学林 ^{1,*} , 张洁 ¹ , 冯玉霞 ¹ , 沈波 ^{1,*} ¹ 人工微结构和介观物理国家重点实验室, 北京大学物理学院, 北京 100871 |
| P-27: 纳米尺度火山口型图形化蓝宝石衬底的制备 陈毅勇, 陈志忠*, 蒋盛翔, 李诚诚, 陈怡帆, 詹景麟, 焦飞, 康香宁, 张国义, 沈波 北京大学, 人工微结构与介观物理国家重点实验室, 北京 100871 |
| P-28: 基于圆包型纳米图形化蓝宝石衬底的GaN基青光LED生长 陈怡帆 ¹ , 陈志忠 ^{1*} , 蒋盛翔 ¹ , 冯玉龙 ¹ , 詹景麟 ¹ , 于彤军 ¹ , 康香宁 ¹ , 焦飞 ¹ , 李顺峰 ² , 张国义 ^{1,2} , 沈波 ¹ ¹ 人工微结构和介观物理国家重点实验室, 北京大学物理学院, 100871 ² 东莞市中镓半导体科技有限公司, 广东省东莞市, 523500 |
| P-29: AlN缓冲层对a面GaN晶体质量的影响研究 迭俊琿, 王彩玮, 严坤, 胡巍, 胡小涛, 江洋*, 陈弘 中国科学院物理研究所, 清洁能源实验室, 北京100190 |
| P-30: 微纳图形蓝宝石衬底外延非极性GaN研究进展 王彩玮 迭俊琿 严坤 胡小涛 胡巍 江洋* 陈弘 北京凝聚态物理国家实验室, 中国科学院物理研究所 北京新能源材料与器件重点实验室 100190 |
| P-31: MOCVD原位生长SiN _x 插入层掩盖位错坑降低GaN位错 胡巍*, 马紫光, 陈弘 中国科学院大学, 物理研究所, 北京 100190 |
| P-32: 基于背后工艺的超薄氮化镓基LED悬空薄膜的制备及表征 李欣, 王永进, 高绪敏, 朱刚毅, 施政 南京邮电大学, 通信与信息工程学院, Peter Grunberg研究中心, 南京市新模范马路66号 210003 |

| |
|--|
| <p>P-33: 微纳结构增强GaN基LED发光特性研究 张国刚1*, 王永进1, 任芳芳2, 刘斌2, 张荣2 1. 南京邮电大学通信与信息工程学院, Peter Grünberg研究中心, 南京 210003 2. 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京210093</p> |
| <p>P-34: GaN基LED应力缓冲层生长方式对外延亮度的影响 朱涛a, b, 曾祥华a* a扬州大学 物理科学与技术学院, 扬州 225000 b淮安澳洋顺昌光电技术有限公司, 淮安 223000</p> |
| <p>P-35: β-Ga₂O₃薄膜的高温MOCVD外延与N型掺杂研究 董鑫*, 胡大强, 李曠明, 张源涛, 张宝林 集成光电子学国家重点联合实验室, 吉林大学电子科学与工程学院, 长春130012</p> |
| <p>P-36: β-Ga₂O₃薄膜的MOCVD外延与特性研究 李曠明, 董鑫*, 李万程, 张宝林, 胡大强, 庄仕伟 吉林大学, 集成光电子学国家联合重点联合实验室吉林大学试验区, 长春 130012</p> |
| <p>P-37: V/III比对N极性GaN薄膜表面形貌的影响 邓高强, 张源涛*, 余焯, 陈靛, 韩煦, 闫龙, 张宝林, 杜国同 集成光电子学国家重点实验室, 吉林大学电子科学与工程学院, 长春 130012</p> |
| <p>P-38: High Reflectivity, Conductive GaN/nanoporous GaN Based Distributed Bragg Reflector Bin Wei1, Yingkuan Han1, Haonan Zhao1, Bowen Sun1, Yanhao Wang2, Xiaokun Yang1, Dezhong Cao1, Haonan Zhao1, Lin Han2, Zhaojun Lin1, Hongdi Xiaol, Yu Zhangl* 1 Department of Microelectronics, Shandong University, Ji'nan 250100, China 2 Institute of Marine Science and technology, Shandong University, Qingdao 250100, China</p> |
| <p>P-39: 基于蛾眼微结构的荧光玻璃制备及其光效提升能力研究 王昊, 梁仁臻, 许琳琳, 戴江南*, 陈长清* 华中科技大学, 武汉光电国家研究中心, 武汉 430074</p> |
| <p>P-40: n反射电极提高深紫外LED的光提取效率 高扬, 王帅, 陈谦, 谭波, 张爽, 王昊, 戴江南*, 陈长清 华中科技大学, 武汉光电国家研究中心, 武汉 430070</p> |
| <p>P-41: 一种新型高效的仿蜂窝状AlGaIn基深紫外发光二极管 张爽, 王帅, 吴峰, 龙瀚凌, 陈景文, 戴江南*, 陈长清* 华中科技大学, 武汉光电国家研究中心, 武汉 430074</p> |
| <p>P-42: 多量子垒LB结构提高AlGaIn基紫外LED的性能 陈谦, 张骏, 高扬, 张爽, 戴江南*, 陈长清 华中科技大学, 光电国家研究中心中心, 武汉 430074</p> |
| <p>P-43: GaN微纳图形的可控制备及MOCVD外延生长研究 宫毛高, 刘斌*, 陶涛, 胡文晓, 谢自力, 张荣*, 郑有焯 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京大学电子科学与工程学院, 南京210093</p> |

| |
|---|
| P-44: PA-MBE生长Al _x Ga _{1-x} N材料工艺以及位错抑制机理研究 李振华, 刘斌*, 吴耀政, 谢自力, 陶涛, 张荣*, 郑有焯 南京大学, 电子科学与工程学院, 南京 210093 |
| P-45: 可调控应变场超短周期 (AlN) _m /(GaN) _n 超晶格 冯向, 卢诗强, 黄凯, 林伟, 高娜*, 陈航洋, 李书平, 康俊勇* 厦门大学物理科学与技术学院, 福建省半导体材料及应用重点实验室, 半导体光电材料及其高效转换器件协同创新中心 |
| P-46: 高空间分辨氮化镓微米孔LED阵列器件的制备与表征 赵毅峰, 刘斌*, 岑旭, 陶涛, 周玉刚, 谢自力, 陈鹏, 陈敦军, 张荣, 郑有焯 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京大学电子科学与工程学院, 中国·南京 210093 |
| P-47: MOCVD生长二维氮化镓工艺研究 胡文晓, 刘斌*, 宫毛高, 陶涛, 谢自力, 张荣*, 郑有焯 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京大学电子科学与工程学院, 中国·南京 210093 |
| P-48: The Optoelectronic Characteristic of Deep Ultraviolet Light-emitting Diodes Ting Zhi1, Tao Tao2*, Bin Liu2*, Zili Xie2, Peng Chen2, Dunjun Chen2, Youdou Zheng2, and Rong Zhang2 1. College of Electronic and Optical Engineering & College of Microelectronics Nanjing University of Posts and Telecommunications 2. Jiangsu Provincial Key Laboratory of Advanced Photonic and Electronic Materials School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University |
| P-49: Hybrid Cyan Nitride/Red Phosphors White Light-emitting Diodes with Micro-hole structures Tao Tao1,2*, Ting Zhi3, Xu Cen1,2, Bin Liu1,2*, Qi Wang1,2, Zili Xie1,2, Peng Chen1,2, Dunjun Chen1,2, Yugang Zhoul,2, Youdou Zheng1,2, Rong Zhang1,2 1. Jiangsu Provincial Key Laboratory of Advanced Photonic and Electronic Materials School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University 2. Nanjing National Laboratory of Microstructures Nanjing University 3. College of Electronic and Optical Engineering & College of Microelectronics Nanjing University |
| P-50: 金属等离子激元耦合距离对表面等离子激元共振增强纳米激光器性能的影响 蒋迪, 刘斌*, 陶涛, 智婷, 桑艺萌, 张荣, 郑有焯 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京大学电子科学与工程学院, 南京 210093 |
| P-51: AlGaN量子阱极化场Mg掺杂调控 卢诗强, 钟志白, 李金钊, 骆宗艳, 陈航洋, 刘达艺, 林伟*, 康俊勇 厦门大学物理科学与技术学院, 福建省半导体材料及应用 重点实验室, 半导体光电材料及其高效转换器件协同创新中心, 福建 厦门 361005 |
| P-52: 基于Mg离子注入实现p型Ga _n 掺杂研究 石娅婷, 徐尉宗, 陈逸虎, 任芳芳*, 周东, 叶建东, 陈敦军, 张荣, 郑有焯, 陆海* 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京210023 |
| P-53: 4H-SiC recessed-window紫外雪崩光电探测器 苏琳琳, 陆海*, 周东, 蔡小龙, 任芳芳, 张荣, 郑有焯 南京大学, 电子科学与工程学院, 南京210093 |
| P-54: 4H-SiC紫外雪崩光电探测器的雪崩均匀性研究 苏琳琳, 蔡小龙, 陆海*, 周东, 任芳芳, 张荣, 郑有焯 南京大学, 电子科学与工程学院, 南京210093 |

| |
|--|
| <p>P-55: 大剂量高能质子辐照对6H-SiC光导型探测器的影响 刘清, 陆海*, 周东, 任芳芳, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京210023</p> |
| <p>P-56: Ni/Au栅金属空气退火对p-GaN帽层结构增强型AlGaIn/GaN HEMT性能影响研究 曾昶琨, 徐尉宗*, 张东, 任芳芳, 周东, 张荣, 郑有焯, 陆海* 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京210023</p> |
| <p>P-57: SiO₂/Si_nx钝化层对GaIn基p-i-n二极管雪崩特性的影响研究 聂凯文, 徐尉宗*, 刘文凯, 任芳芳, 周东, 张荣, 郑有焯, 陆海* 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京210023</p> |
| <p>P-58: 高质量Si掺杂β-Ga₂O₃薄膜同质外延研究 陈选虎, 叶建东*, 顾书林, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京210023</p> |
| <p>P-59: 高质量α相Ga₂O₃的MIST-CVD异质外延研究 马同川, 陈选虎, 叶建东*, 顾书林, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京210023</p> |
| <p>P-60: MIST-CVD外延ε-Ga₂O₃薄膜及高温退火相变研究 马同川, 况悦, 陈选虎, 叶建东*, 顾书林, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京210023</p> |
| <p>P-61: Reduced-threshold amplified spontaneous emissions from large-sized single crystalline ZnO flexible membrane Y. F. Zhang¹, F. F. Qin², X. H. Chen¹, F.-F. Ren¹, S. L. Gul, R. Zhang¹, Y. D. Zheng¹, C. X. Xu^{2*}, J. D. Ye^{1*} 1 School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093 2 Southeast Univ, Sch Biol Sci & Med Engn, State Key Lab Bioelect, Nanjing 210096, China</p> |
| <p>P-62: 卤化物气相外延在超宽禁带半导体氧化镓中的应用 修向前*, 李悦文, 熊泽宁, 朱宇霞, 华雪梅, 谢自力, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院, 光电信息功能材料重点实验室, 南京 210023</p> |
| <p>P-63: HVPE-Ga₂O₃薄膜的氮化研究 李悦文, 修向前*, 华雪梅, 谢自力, 陈鹏, 刘斌, 张荣, 郑有焯 南京大学 电子科学与工程学院, 光电信息功能材料重点实验室, 南京210023</p> |
| <p>P-64: HVPE法生长 β-Ga₂O₃薄膜的退火研究 朱宇霞, 李悦文, 修向前*, 熊泽宁, 华雪梅, 谢自力, 陈鹏, 刘斌, 陶涛, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院, 光电信息功能材料重点实验室, 南京210023</p> |
| <p>P-65: 石墨烯-Ag纳米点透明导电层(TCL)中Ag原子层厚度对GaIn基紫外发光二极管电学和光学特性的影响 陈伟, 陆佑铭, 周玉刚*, 余显正, 谢自力, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京 210023</p> |
| <p>P-66: 异质结增强型AlGaIn日盲APD的电场调控 游海帆, 王逸然, 乔新凯, 陈敦军*, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京 210093</p> |

| |
|---|
| <p>P-67: 非故意掺杂GaN缓冲层中缺陷对p-GaN栅结构AlGaIn/GaN高电子迁移率晶体管负跨导效应影响 葛梅, 蔡青, 张保花, 陈敦军*, 胡立群, 张荣, 郑有焯 南京大学电子科学与工程学院 江苏南京 210093</p> |
| <p>P-68: 铍化物超晶格的MOCVD生长优化 李欣a, b, 赵宇b, 吴启花b, 滕葵a, b, 郝修军b, c, 黄勇a, b * a中国科学技术大学, 纳米技术与纳米仿生学院, 合肥 安徽230026 b中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 纳米器件与应用重点实验室, 苏州 江苏 215123 c上海科技大学, 物质科学与技术学院, 上海 201210</p> |
| <p>P-69: Growth model of van der Waals epitaxy of films: A case of AlN films on multilayer graphene/SiC Yu Xu, 1, 2, 3 Bing Cao, 4, 5, * Zongyao Li, 4, 5 Demin Cai, 2 Jianfeng Wang, 1, 2 Lin Shi, 1, 2 Chinhua Wang, 4, 5 ,Ke Xu, 1, 2, 1. Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics (SINANO), Chinese Academy of Sciences (CAS), Suzhou 2. Suzhou Nanowin Science and Technology Co., Ltd., Suzhou 215123, P. R. China. 3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China. 4. College of Physics, Optoelectronics and Energy and Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Soochow University, Suzhou 215006, P. R. China. 5. Key Lab of Advanced Optical Manufacturing Technologies of Jiangsu Province and Key Lab of Modern Optical Technologies of Education Ministry of China, Soochow University, Suzhou 215006, P. R. China</p> |
| <p>P-70: 硅基GaN准垂直结构功率二极管的制备研究 何俊蕾1, 2, 钟耀宗1, 2, 周宇2, 苏帅1, 2, 高宏伟2, 黄应南1, 2, 孙钱* 1, 2, 杨辉1, 2 1. 中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院, 合肥, 230026 2. 中国科学院纳米器件与应用重点实验室, 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 苏州, 215123</p> |
| <p>P-71: MOCVD生长AlN的气相反应路径理论研究 张莲, 张红, 左然* 江苏大学, 能源动力学院, 镇江 212013</p> |
| <p>P-72: GaN MOVPE气相反应中自由基的作用 张红, 左然* 江苏大学, 能源与动力工程学院, 镇江 212013</p> |
| <p>P-73: MOCVD晶体外延文献数据知识库的研究 孙敬玺+, 顾书林*, 纪荣嵘**, 周乃君, 张正贵, 汪范生, 孙德军 广东家易科技有限公司, 惠州, 516083 *南京大学, 电子科学与工程学院, 南京, 210023 **厦门大学, 信息学院智能科学系, 厦门, 361005</p> |
| <p>P-74: 新型GaN半导体薄膜低温外延技术研究 于汪洋, 罗毅*, 张子轩, 余佳东, 路博洋, 汪莱, 王健, 郝智彪, 孙长征, 韩彦军, 熊兵, 李洪涛 清华大学电子工程系, 北京信息科学与技术国家研究中心集成光电子学重点实验室, 北京 100084</p> |
| <p>P-75: 石墨烯/石英玻璃衬底上的GaN低温生长研究 余佳东, 汪莱*, 吴超, 于汪洋, 邓军, 路博洋, 张子轩, 李翔, 郝智彪, 王健, 罗毅*, 孙长征, 韩彦军, 熊兵, 李洪涛 清华大学电子工程系, 北京信息科学与技术国家研究中心集成光电子学重点实验室, 北京 100084</p> |

| |
|---|
| <p>P-76: GaN基绿光LED的光学特性和内量子效率测量研究 路博洋a, 汪莱a,* , 郝智彪a, 罗毅a,* , 孙长征a, 韩彦军a, 熊兵a, 王健a, 李洪涛a, 陈凯轩b, 卓祥景b, 李金钗c, 康俊勇c a清华大学电子工程系, 北京信息科学与技术国家研究中心集成光电子学重点实验室, 北京 100084 b厦门乾照光电股份有限公司, 厦门 361101 c厦门大学物理系, 福建省半导体材料及应用重点实验室, 半导体光电材料及其高效转换器件协同创新中心, 厦门 361005</p> |
| <p>P-77: MOCVD反应室无镓无铝环境的获得及重要性分析 杨超普1, 方文卿2*, 宋亚峰3, 阳帆2 (1 商洛学院 化学工程与现代材料学院, 陕西 商洛 726000) (2 南昌大学 国家硅基LED工程技术研究中心, 江西 南昌 330047) (3商洛学院 电子信息与电气工程学院, 陕西 商洛 726000)</p> |
| <p>P-78: 初始应力对垂直结构GaN基LED光电性能影响的研究1 熊传兵1, 汤英文1, 黄基锋2 闽南师范大学, 物理与信息工程学院, 漳州 363000 南昌大学, 国家硅基LED工程技术研究中心, 南昌330047</p> |
| <p>P-79: 电流对不同厚度GaN基白光LED可靠性的影响及光电特性的研究 曾繁响, 刘倩, 熊传兵 闽南师范大学, 物理与信息工程学院, 漳州 363000</p> |
| <p>P-80: Growth and characterization of Ga₂O₃ nanocrystal from MOVPE grown GaN template by electrochemical reaction Yufeng Li, Xilin Su, Peng Hu, Mengqi Du, Lungang Feng, Maofeng Guo, Ye Zhang, Feng Yun* and Xun Hou 1Key Laboratory of Physical Electronics and Devices of Ministry of Education and Shaanxi Provincial Key Laboratory of Photonics & Information Technology, Xi' an Jiaotong University, Xi' an, Shaanxi 2Solid-State Lighting Engineering Research Center, Xi' an Jiaotong University, Xi' an, Shaanxi 710049</p> |
| <p>P-81: Fabrication and characterization of high Q-InGaN quantum-well based microdisk Mengqi Du, Yufeng Li, Peng Hu, Ye Zhang, and Feng Yun* Key Laboratory for Physical Electronics and Devices of the Ministry of Education and Shaanxi Provincial Key Laboratory of Photonics & Information Technology, Xi' an Jiaotong University, Xi' an, 710049, China Solid-State Lighting Engineering Research Center, Xi' an Jiaotong University, Xi' an, 710049, China</p> |
| <p>P-82: Investigation of the quantum efficiency of GaN-based light-emitting diodes on PSS in high spatial resolution Chenyu Wang, Yufeng Li, Ye Zhang and Feng Yun* Key Laboratory for Physical Electronics and Devices of the Ministry of Education and Shaanxi Provincial Key Laboratory of Photonics & Information Technology, Xi' an Jiaotong University, Xi' an, 710049, China Solid-State Lighting Engineering Research Center, Xi' an Jiaotong University, Xi' an, 710049, China</p> |
| <p>P-83: Performance Enhancement of AlGaIn-based 365 nm UV-LEDs with a Band-engineering Last Quantum Barrier He Longfei(贺龙飞)1,2, Zhao Wei(赵维)1, Zhang Kang(张康)1, He Chenguang(何晨光)1, Wu Hualong(吴华龙)1, Liu Xiaoyan(刘晓燕)1, Chen Zhitao(陈志涛)1,* , Li Shutu(李述体)2,* 1Guangdong Institute of Semiconductor Industrial Technology, Guangdong Academy of Sciences, Guangzhou 510650 2Institute of Opto-Electronic Materials and Technology, South China Normal University, Guangzhou 510631</p> |

| |
|---|
| <p>P-84: 低导通电阻氮化镓基半垂直肖特基二极管 任远a, 卢星b, 刘晓燕a, 张康a, 陈志涛a*, 张佰君c a. 广东省半导体产业技术研究院, 广州, 510650; b. 华南理工大学, 微电子学院, 广州, 510641; c. 中山大学, 电子信息与工程技术学院, 广州, 510275</p> |
| <p>P-85: Al_xGa_{1-x}N/Al_yGa_{1-y}N/Al_xGa_{1-x}N (x>y) 电子阻挡层对氮化物深紫外LED空穴注入的影响 楚春双, 田康凯, 张勇辉, 毕文刚, 张紫辉* 河北工业大学电子信息工程学院, 天津电子材料与器件重点实验室, 天津 300401</p> |
| <p>P-86: 基于深紫外LED中电子注入源层的Si掺杂浓度对于电场和载流子注入影响的研究 方梦倩1, 2, 田康凯1, 2, 楚春双1, 2, 张勇辉1, 2, 张紫辉1, 2, *, 毕文刚1, 2, * 1 天津市北辰区西平路5340号河北工业大学电子与信息工程学院微纳米光电子与电磁技术创新研究所, 300401, 中国 2 天津市电子材料与器件重点实验室, 天津市北辰区西平路5340号, 300401, 中国</p> |
| <p>P-87: 半绝缘GaN晶体的制备及应用 李珣* 河北工业大学, 电子信息工程学院, 天津 300401</p> |
| <p>P-88: GaP粗化对AlGaInP发光二极管光电特性的影响 肖和平*, 朱迪 扬州乾照光电有限公司, 江苏省扬州市东风河西路8号, 225101</p> |
| <p>P-89: 高耐压复合介质层GaN基梯形二极管新结构研究 汪浩, 杜江锋*, 辛奇, 白智元, 刘勇, 于奇 电子科技大学, 电子薄膜与集成器件国家重点实验室, 成都 610054</p> |
| <p>P-90: GaN基材料p型掺杂机理及光电性质的模拟研究 张志伟, 陈一仁, 缪国庆, 李志明, 蒋红, 宋航* 中国科学院长春光机所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130033</p> |
| <p>P-91: 高性能背照射AlGaIn基日盲紫外探测器研制 宋航, 陈一仁, 张志伟, 李志明, 蒋红, 缪国庆 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130033</p> |
| <p>P-92: 高性能背照射MIS结构AlGaIn基日盲紫外探测器 蒋红, 陈一仁, 张志伟, 缪国庆, 李志明, 宋航 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130033</p> |
| <p>P-93: 阶梯状InGaIn量子阱LED的光学性质研究 李毅* 南通大学, 电子信息学院&通科微电子学院, 南通 226019</p> |
| <p>P-94: AlGaInAs量子阱材料退火中的发光演变 曾玉刚*, 宋悦, 宁永强 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130033</p> |

| |
|--|
| <p>P-95: AlN上的欧姆接触研究</p> <p>李金峰¹ 李雪威² 张纪才^{1,2} 徐科^{2,3}</p> <p>1北京化工大学理学院物理系, 北京 100029</p> <p>2中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 苏州, 215123</p> <p>3苏州纳维科技有限公司, 苏州, 215123</p> |
| <p>P-96: InGaN基LED的效率评价及应用研究</p> <p>路慧敏^{a,*}, 于彤军^b, 王建萍^a</p> <p>a北京科技大学, 计算机与通信工程学院, 北京 100083; b北京大学, 物理学院, 北京 100871</p> |
| <p>P-97: 垒层和阱层厚度对InGaN量子阱发光特性的影响及机理</p> <p>周梅^{1,*}, 黄佳琳¹, 易淋凯¹, 刘炜², 江德生², 赵德刚²</p> <p>1中国农业大学, 理学院应用物理系, 北京 100083</p> <p>2中国科学院半导体研究所, 集成光电子学国家重点实验室, 北京 100083</p> |
| <p>P-98: 衬底斜切角对p型GaN电学性能的影响</p> <p>江灵荣^{1,2}, 刘建平^{* 1,2}, 田爱琴², 任霄钰², 杨辉^{1,2}</p> <p>1. 中国科学技术大学, 纳米技术与纳米仿生学院, 合肥, 215123</p> <p>2. 中国科学院纳米器件与应用重点实验室, 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 苏州, 215123</p> |
| <p>P-99: GaAs平面掺杂势垒二极管</p> <p>张宇, 车相辉, 杨实, 杨中月, 陈宏泰</p> <p>中国电子科技集团第十三研究所, 石家庄 050000</p> |
| <p>P-100: 高功率低噪声脊波导DFB激光器芯片的研究</p> <p>车相辉[*], 曹晨涛, 于浩, 陈宏泰, 赵润</p> <p>中国电子科技集团公司第十三研究所, 石家庄, 050051</p> |

8月23日（星期四）

| 分会报告 | 激光器材料与器件（三） | LED及探测器材料与器件（三） | 电力电子器件（三） | 其他器件及应用（三） |
|-----------|--|--|--|---|
| 主持人 | 石芝铭 | 汪莱 | 张源涛 | 李述体 |
| 8:00-8:25 | <p>IA5(邀请报告):高质量、大尺寸氮化镓单晶衬底研究与应用进展 王建峰, 徐科*, 任国强, 张育民, 蔡德敏, 徐俞, 张纪才, 胡晓剑, 王明月 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 苏州纳维科技有限公司, 苏州 215125</p> | <p>IB5(邀请报告): III族氮化物半导体MOCVD及MBE外延生长及光电子器件应用 刘斌, 陶涛, 吴耀政, 李振华, 宫毛高, 胡文晓, 谢自力, 修向前, 陈敦军, 陆海, 张荣, 郑有焘 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京大学电子科学与工程学院, 南京210093</p> | <p>IC5(邀请报告): GaN基光电子材料与器件 赵德刚*, 杨静, 梁锋, 刘宗顺, 朱建军, 陈平, 江德生 中国科学院半导体研究所, 集成光电子学国家重点实验室, 北京 100083</p> | <p>ID5(邀请报告): AlGaIn材料中的缺陷研究 孙晓娟, 开翠红, 蒋科, 贲建伟, 石芝铭, 贾玉萍, 刘贺男, 黎大兵* 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130033</p> |
| 8:25-8:50 | <p>IA6(邀请报告):新型氮化物光电子器件 胡卫国* 中国科学院北京纳米能源与系统研究所, 北京 100083</p> | <p>IB6(邀请报告): 高质量AlN外延生长及AlGaIn基深紫外LED研究 许福军, 沈波 北京大学, 宽禁带半导体研究中心, 北京 100871</p> | <p>IC6(邀请报告): 常关型AlGaIn/GaN异质结场效应晶体管 王霄, 黄倩, 王婷婷, 补钰煜, 郝跃, 敖金平* 西安电子科技大学, 微电子学院, 西安 710071</p> | <p>ID6(邀请报告): 高铟组分InGaIn的MOCVD外延生长及薄膜缺陷研究 梁红伟*, 刘建勋, 夏晓川, 张贺秋, 柳阳, 申人升 大连理工大学微电子学院, 大连 116024</p> |
| 8:50-9:03 | <p>0A11(口头报告): 980nm非对称波导大光腔激光器研究 赵勇明1, 孙玉润1, 于淑珍1, 黄杰1,2, 周坤3, 杜维川3, 康俊杰3, 李弋3, 高松信3, 董建荣1* 1中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 中科院纳米器件与应用重点实验室, 苏州 215123 2中国科学院大学, 北京 100049 3中国工程物理研究院应用电子学研究所, 绵阳, 621900</p> | <p>0B11(口头报告):宏台阶上AlGaIn基深紫外类量子线结构的生长与特性 孙元浩, 许福军*, 王明星, 刘百银, 郎婧, 张娜, 沈波 北京大学物理学院, 宽禁带半导体研究中心, 北京 100871</p> | <p>0C11(口头报告):2-inch and 4-inch free-standing GaN substrates made by HVPE Dr. Qing Wang, Dr. Wenrong Zhuang, Dr. Boping Wang, Jiejun Wu, Nanliu Liu, Yuanhao Zhang, Chuxiong Hu, Junjie Ren, Linhui Zhu, Run Chen, Luo Li, Shuai Wang, and Diangang Hu. SINO NITRIDE SEMICONDUCTOR CO.,LTD</p> | <p>0D11(口头报告):氢等离子体处理p-GaN混合阳极二极管 于国浩, 唐文欣, 郝荣晖, 陈扶, 张晓东, 蔡勇, 张宝顺* 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 加工平台, 苏州 215123</p> |

| | | | | |
|------------------|---|--|---|---|
| <p>9:03-9:16</p> | <p>OA12 (口头报告): AlGaIn的高压偏振光谱研究 付雷, 唐宁*, 管鸿明, 张云帆, 葛惟昆, 沈波 北京大学人工微结构与介观物理国家重点实验室, 北京大学物理学院, 北京100871</p> | <p>OB12 (口头报告): 准备层结构对硅衬底氮化镓基绿光LEDs性能的影响 江兴安, 郑畅达*, 吴小明, 刘军林, 江风益 南昌大学, 国家硅基LED工程技术研究中心, 南昌 330000</p> | <p>OC12 (口头报告): AlGaIn极性调控及横向极性结构多层量子阱发光特性研究 郭炜* 蒋洁安, Moheb Sheikhi, 叶继春 中国科学院宁波材料技术与工程研究所, 浙江省宁波市镇海区, 315201</p> | <p>OD12 (口头报告): GaN中子探测器 朱志甫1,2, 邹继军1,2*, 汤彬1, 彭新村2, 瞿金辉1, 彭俊波2, 王智栋2, 王伟路2, 邓文娟2 1. 核技术应用教育部工程研究中心 (东华理工大学), 南昌 330013; 2. 东华理工大学江西省新能源工艺与装备工程技术研究中心, 南昌 330013</p> |
| <p>9:16-9:29</p> | <p>OA13 (口头报告): 原子层沉积生长GZO薄膜及其性能的研究 陶佳佳, 顾洋, 李幸, 马宏平, 卢红亮* 复旦大学, 微纳电子器件与工艺实验室, 上海 200433</p> | <p>OB13 (口头报告): 覆铜氧化铝陶瓷基板封装的AlGaIn基深紫外LED的热性能研究 许琳琳, 梁仁臻, 龙瀚凌, 王昊, 陈长清*, 戴江南* 华中科技大学, 武汉光电国家研究中心, 武汉 430074</p> | <p>OC13 (口头报告): 9N气体纯化器研制进展及在半导体12寸产线的应用 侯鹏 大连华邦化学有限公司</p> | <p>OD13 (口头报告): 金刚石光电材料与器件研究 单崇新1,*, 卢英杰1, 林超男1, 申德振2 1 郑州大学物理工程学院, 郑州 450052 2 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春130033</p> |
| <p>9:29-9:42</p> | <p>OA14 (口头报告): 非极性AlGaIn薄膜的MOCVD调制脉冲生长 何佳琦, 张雄*, 庄喆, 赵见国, 范艾杰, 吴自力, 陈帅, 崔一平 东南大学, 电子科学与工程学院先进光子学中心, 南京 210096</p> | <p>OB14 (口头报告): MOCVD外延生长的InAs/GaSb超晶格长波红外探测器 赵宇1, 李欣1, 吴启花1, 滕葵1, 郝修军1, 熊敏2, 黄勇*, 1, 1 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 纳米器件及相关材料研究部, 苏州 215123 2 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 纳米加工平台, 苏州 215123</p> | <p>OC14 (口头报告): AlGaIn/GaN HEMT功率电子器件动态导通阻抗的精确提取 雷建明1, 王蕊1, 汪金1, 陈敦军*1, 陆海1, 张荣1, 郑有钊1 1 南京大学, 电子科学与工程学院, 南京, 210023</p> | <p>OD14 (口头报告): 超高开关比氧化镓肖特基二极管研制 徐阳, 陈选虎, 程亮, 叶建东*, 顾书林, 陆海, 张荣, 郑有钊 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京210023</p> |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| 9:42-9:55 | <p>OA15(口头报告): 硅衬底上生长的GaN基高亮度绿光LED技术研究进展</p> <p>吕全江, 刘军林*, 莫春兰, 张建立, 吴小明, 江风益 南昌大学, 国家硅基LED工程技术研究中心, 南昌 330000</p> | <p>OB15(口头报告): SiC衬底上GaN基垂直结构近紫外LED的制备研究</p> <p>韩煦, 张源涛*, 李鹏翀, 闫龙, 邓高强, 陈靛, 余焯, 殷景志 集成光电子学国家重点实验室, 吉林大学电子科学与工程学院, 长春 130012</p> | <p>OC15(口头报告): SiNx插入层对于非极性面AlGaIn薄膜晶体质量及偏振特性调控研究</p> <p>张毅, 戴江南*, 龙瀚凌, 陈景文, 张骏, 陈长清 (作者栏使用宋体四号) 华中科技大学, 武汉光电国家研究中心, 武汉 430074</p> | <p>OD15(口头报告): AlGaIn/GaN上原位生长SiNx介质及前栅工艺兼容性研究</p> <p>程亮, 徐尉宗*, 任芳芳, 周东, 张荣, 郑有焯, 陆海* 南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京 210023</p> |
| 9:55-10:15 | 茶歇 | | | |
| 分会报告 | 激光器材料与器件(四) | LED及探测器材料与器件(四) | 电力电子器件(四) | 其他器件及应用(四) |
| 主持人 | 王建峰 | 许福军 | 赵德刚 | 梁红伟 |
| 10:15-10:40 | <p>IA7(邀请报告): 低维氮化硼带隙调控的第一性原理研究1</p> <p>石芝铭, 孙晓娟, 贾玉萍, 刘贺男, 黎大兵* 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春130033</p> | <p>IB7(邀请报告): 面向可见光通信的GaIn基高速LED</p> <p>R. Kamran, 汪莱*, 郝智彪, 罗毅, 孙长征, 韩彦军, 熊兵, 王健, 李洪涛 清华大学电子工程系, 北京信息科学与技术国家研究中心, 北京 100084</p> | <p>IC7(邀请报告): 氮极性III族氮化物材料的MOCVD外延生长研究</p> <p>张源涛* 集成光电子学国家重点实验室, 吉林大学电子科学与工程学院, 长春 130012</p> | <p>ID7(邀请报告): MOCVD制备氮化物纳米线及性能研究</p> <p>王幸福, 宋伟东, 陈航, 李述体* 广东省光电功能材料与器件工程技术研究中心, 华南师范大学光电子材料与技术研究所, 广州 510631</p> |
| 10:40-10:53 | <p>IA8(邀请报告): UVC LED structure growth on 4 inch Sapphire Wafer using HT MOCVD</p> <p>Myeongseok Oh TES Co. Ltd, 2374-36 Jungbu-Daero, Yangji-Myun, Cheoin-Gu, Yongin-si, Republic of Korea</p> | <p>OB16(口头报告): ZnMgO薄膜紫外探测器的制备和特性研究</p> <p>刘可为*, 陈星, 王潇, 朱勇学, 范明明, 陈洪宇, 申德振 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130033</p> | <p>IC8(邀请报告): High quality crack free AlGaIn/AlN based material grown with AMEC Prismo HT3 MOCVD for UVC applications</p> <p>Jason Hoo*, Yao Chen, Vincent Wang, Shiping Guo Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., 188 Taihua Road, Shanghai 201201</p> | <p>ID8(邀请报告): MOCVD在线监测技术的一些进展</p> <p>黄文勇, 马铁中*, 郭春磊 昂坤视觉(北京)科技有限公司, 昌平区新元科技园B503, 北京 102206 中微半导体设备(上海)有限公司, 泰华路188号, 上海 201201</p> |

| | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|
| <p>10:53-11:06</p> | | <p>OB17 (口头报告): 双PN结红外 940 nm发光二极管研究 林鸿亮, 石时曼, 田海军, 杨默, 储开明, 杨凯, 李全素 (扬州乾照光电有限公司, 江苏 扬州 225009) 曾祥华*(扬州大学 物理科学与技术学院, 江苏 扬州 225002)</p> | | |
| <p>11:06-11:19</p> | <p>OA16 (口头报告): 国产MOCVD装备的关键技术创新 邢志刚, 林桂荣, 巩前程, 王国斌, 栾振兴, 刘雷, 陈晓, 金小亮, 陈爱华, 张伟 中晟光电设备(上海)股份有限公司</p> | <p>OB18(口头报告): 基于MOCVD二次外延生长的p型栅GaN基增强型HEMT 钟耀宗, 周宇, 苏帅, 高宏伟, 何俊蕾, 戴淑君, 孙钱*, 杨辉 1. 中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院, 合肥, 230026 2. 中国科学院纳米器件与应用重点实验室, 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 苏州, 215123</p> | <p>OC16 (口头报告): 用于化合物半导体MOCVD生长的气体纯化器 江晓松, 唐浩 先普半导体技术(上海)有限公司, 春光路99弄18号一号楼5楼, 上海 201108</p> | <p>OD16(口头报告): 纳米图形蓝宝石C面石墨烯上MOCVD外延高质量AlN薄膜 常洪亮, 陈召龙, 郭亚楠, 魏同波*, 王军喜, 李晋闽 中国科学院半导体研究所, 北京市海淀区清华东路甲35号, 100083</p> |

| | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|
| <p>11:19-11:32</p> | <p>OA17(口头报告): 基于纳米异质外延制备高性能近紫外LED研究 王昆, 李孟达, 王慧、路慧敏、于彤军* 北京大学宽禁带半导体研究中心, 人工微结构和介观物理国家重点实验室, 北京, 100871</p> | <p>OB19(口头报告): Hybrid Cyan Nitride/Red Phosphors White Light-emitting Diodes with Micro-hole structures Tao Tao^{1,2*}, Ting Zhi³, Xu Cen^{1,2}, Bin Liu^{1,2*}, Qi Wang^{1,2}, Zili Xie^{1,2}, Peng Chen^{1,2}, Dunjun Chen^{1,2}, Yugang Zhou^{1,2}, Youdou Zheng^{1,2}, and Rong Zhang^{1,2} 1. Jiangsu Provincial Key Laboratory of Advanced Photonic and Electronic Materials School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University 2. Nanjing National Laboratory of Microstructures Nanjing University 3. College of Electronic and Optical Engineering & College of Microelectronics Nanjing University of Posts and Telecommunications</p> | <p>OC17(口头报告): 高纯溶液二茂镁的制备 万欣 董礼 徐耀中 刘子伟 刘宇常华 江苏南大光电材料股份有限公司 江苏苏州 215021</p> | <p>OD17(口头报告): 分子束同质外延GaN薄膜工艺研究 吴耀政; 刘斌*; 李振华; 陶涛; 谢自力**; 修向前; 陈鹏; 陈敦军; 陆海; 施毅; 张荣; 郑有焘 江苏省光电信息功能材料重点实验室, 南京大学电子科学与工程学院, 南京210093</p> |
|--------------------|--|--|---|--|

| | | | | |
|--------------------|---|--|---|---|
| <p>11:32-11:45</p> | <p>0A18(口头报告):蓝宝石上GaN基p-i-n二极管雪崩击穿特性与退化机制研究 徐尉宗*, 聂凯文, 刘文凯, 周东, 任芳芳, 张荣, 郑有焯, 陆海*</p> <p>南京大学电子科学与工程学院, 江苏省光电功能材料重点实验室, 南京 210023</p> | <p>0B20(口头报告):纳米图形化氮化铝模版上高质量氮化铝的外延生长 解楠, 许福军*, 王明星, 孙元浩, 刘百银, 沈波*</p> <p>北京大学, 宽禁带半导体中心, 北京 100871</p> | <p>0C18(口头报告):Growth and characterization of Ga2O3 nanocrystal from MOVPE grown GaN template by electrochemical reaction Yufeng Li, Xilin Su, Peng Hu, Mengqi Du, Lungang Feng, Maofeng Guo, Ye Zhang, Feng Yun* and Xun Hou</p> <p>1Key Laboratory of Physical Electronics and Devices of Ministry of Education and Shaanxi Provincial Key Laboratory of Photonics & Information Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi 710049, People's Republic of China</p> <p>2Solid-State Lighting Engineering Research Center, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi 710049, People's Republic of China</p> | <p>0D18(口头报告): 图形化Si(100)衬底外延立方系GaN 王琦, 袁国栋*, 刘文强, 张璐, 王军喜, 李晋闽</p> <p>中国科学院半导体研究所, 半导体照明研发中心, 北京, 100083</p> |
| <p>12:00-13:30</p> | <p>午餐</p> | | | |

| 大会报告(8月23日 星期四) | |
|-----------------|---|
| 主持人 | 李晋闽 |
| 13:30-14:00 | F7: 氮化物半导体及其量子结构的大失配异质外延 沈波 北京大学宽禁带半导体研究中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室, 北京 100871 |
| 14:00-14:30 | F8: 半导体异质结能带结构band-offset研究进展 黄增立 杨辉* 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 江苏省苏州市工业园区若水路398号 215123 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 纳米真空互联实验站 |
| 14:30-15:00 | F9: GaAs基大功率半导体激光器的材料设计及生长研究 徐现刚 ^{1,2*} , 朱振 ² ¹ 山东大学, 晶体材料国家重点实验室, 济南 250100; ² 山东华光光电子股份有限公司, 济南 250100 |
| 15:00-15:15 | 茶歇 |
| 主持人 | 徐现刚 |
| 15:15-15:45 | F10: 宽带氧化物半导体光电特性研究 长春光学精密机械与物理研究所, 发光学及应用国家重点实验室, 长春 130013 申德振 |
| 15:45-16:15 | F11: 硅衬底InGaN基长波段LED光电特性研究 张建立*, 刘军林, 王小兰, 莫春兰, 全知觉, 郑畅达, 江风益 南昌大学, 国家硅基LED工程技术研究中心, 南昌 330000 |
| 16:15-17:00 | 闭幕式 |
| 18:00-20:00 | 晚宴 |
| 8月24日星期五 参观考察 | |